

резко уменьшается от $V_a \approx 40$ В до 10 В при $i \approx 15-20$ А. Из-за большой плотности тока анод в пятне испаряется (температура ≈ 4200 К), при этом дуга «шипит».

Для мощных (10^2-10^3 кВт) электродуговых устройств важнейшей является проблема эрозии электродов, в осо-

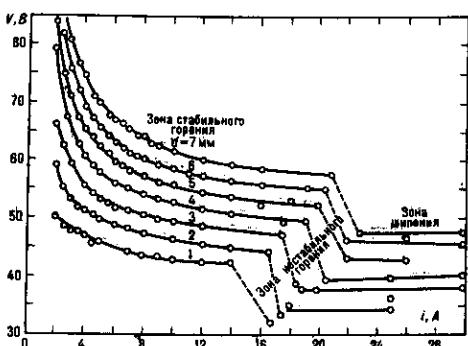


Рис. 7. ВАХ угольной дуги в воздухе; d — расстояние между электродами.

бенности катода. Даже тугоплавкие материалы, такие как вольфрам, подвержены разрушению и испарению, в особенности в катодных пятнах, где плотность тока достигает 10^7 А/см². В катодных пятнах происходит термоавтоэлектронная эмиссия — сочетание действия температуры $T \approx 3000-5000$ К и полевой эмиссии ($E \gtrsim 10^7$ В/см). Катодные пятна всегда образуются вакуумных дугах с металлическими электродами, используемых в вакуумных переключателях. В дугах высокого давления ($p \gtrsim 10$ атм) в Нг, Хе подавляющая часть джоулева тепла уносится излучением, что используется для изготовления дуговых ламп (см. Источники оптического излучения). В ряде приборов применяется низковольтная дуга низкого давления ($p \sim 1$ тор, $V \approx 10-20$ В, $i \sim 1$ А) с искусственно накаливаемым катодом.

Высокочастотные разряды бывают двух типов: индукционные (ВЧИ) и ёмкостные (ВЧЕ). Безэлектродный ВЧИ-разряд обычно зажигают внутри диэлектрической трубки, вставленной в катушку (достаточно и неск. витков), по которой пропускается ВЧ-ток (рис. 8, а). В этом случае перем-

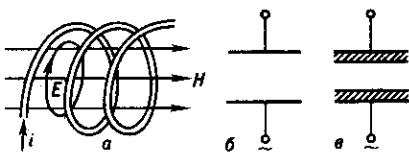


Рис. 8. Способы возбуждения ВЧ-разрядов: а — индукционный; б — ёмкостный; в — ёмкостный безэлектродный (изоляторы защтрихованы).

продольное магн. поле индуцирует в разрядной плазме кольцевые замкнутые поле E и токи. ВЧИ-разряды чаще зажигают при $p \approx 1$ атм. Плазма ВЧИ-разряда равновесна, подобно плазме столба дуги, $T \approx 8000-11000$ К. В устройствах небольшой мощности (~ 1 кВт) тепло отводится за счёт теплопроводности к охлаждаемым стенкам; в мощных устройствах ($\sim 10-10^3$ кВт) по трубке пропускают газ со скоростью ~ 1 м/с. Поток отжимает плазму от стенок и выносит тепло с плазменной струёй. Режим горения оптимален при таких темперах T , проводимости $\sigma(T)$ и радиусе плазменного столба R , что толщина скин-слоя $\delta = c/\sqrt{2\mu\sigma}$, на который ВЧ-поле проникает в проводник, меньше, но сравнима с $R \sim 1-2$ см.

ВЧЕ-разряд при низких и ср. давлениях ($p \sim 10^{-1}-10^2$ тор) обычно зажигают, подавая ВЧ-напряжение на плоские электроды. Электроды могут быть и оголёнными, и изолированными от плазмы диэлектрическими пластинами (рис. 8, б, в). Весь разрядный объём в плоском промежутке

заполнен малоподвижными ионами. На их фоне электроны совершают дрейфовые колебания, так что граница плазмы, где $n_e = n_i$, также перемещается, поочерёдно касаясь одной из твёрдых поверхностей. При этом обнажается ионный слой положит. пространственного заряда около противоположной поверхности. Нехватка электронов в промежутке, отчего и получаются приэлектродные слои, возникает из-за того, что находившиеся вблизи поверхностей электроны в самом начале либо уходят в металл, либо прилипают к изолирующим электродам пластина.

Существуют две формы горения ВЧЕ-разряда. В α -форме приэлектродные слои практически лишены проводимости и плазменный ток замыкается на электроды токами смещения. Этому режиму соответствуют небольшие плотности тока $j \sim 10$ мА/см² при $p \sim 20$ тор. При достаточно сильном общем токе и плотности зарядов в плазме $n \gtrsim 10^{10}$ см⁻³ (γ -форма горения разряда) происходит таунсендовский пробой слоёв и у обоих электродов образуются слои с ионным током и вторичной эмиссией (в т. ч. и с диэлектрика, откуда срываются прилипшие электроны), очень похожие на катодный слой тлеющего разряда. В этой форме разряда ток $j \sim 10^2$ мА/см², а толщина слоёв (при средних давлениях) на порядок меньше, чем в α -режиме, и близка к d_n нормального тлеющего разряда. В этих слоях сочетаются ток проводимости и ток смещения. Когда ВЧ-напряжение подают на единственный электрод, возникает **факельный разряд**.

СВЧ-разряды зажигают в резонаторах, в диэлектрической трубке, пересекающей волновод; в последнем случае обычно при $p=1$ атм. Как и в ВЧИ-разряде, через трубку пропускают газ. Разрядная плазма квазиравновесна, но температура при мощностях ~ 1 кВт $\sim 4000-6000$ К. Она не поднимается выше, т. к. от сильнее ионизованной плазмы СВЧ-излучение отражается (см. также *Оптические разряды*).

Искровой разряд. Первой стадией этого разряда служит стримерный, а чаще лидерный пробой — прорастание тонкого плазменного канала от одного электрода к другому (см. Стримеры, Пробой газа). Потом канал превращается в искровой, способный пропустить сильный ток («короткое замыкание»). Важнейшим элементом искрового пробоя является стример, к-рый зарождается от мощной электронной лавины, в простейшем случае — около самого анода. Электроны, содроточенные вблизи переднего фронта лавины, уходят в анод, оставляя положительно заряженный ионный след. Возбуждённые в лавине молекулы испускают фотоны, к-рые производят фотоионизацию. Фотоэлектроны дают начало вторичным электронным лавинам, к-рые втягиваются в ионный след, являющийся источником сильного поля. Смешиваясь с ионами первичной лавины, электроны вторичных образуют плазму, а во вторичные ионные следы втягиваются лавины следующего поколения и т. д. Процесс происходит непрерывно, и от анода прорастает плазменный канал — стример.

Лавинно-стримерный переход может произойти лишь при сильном внеш. поле E_0 , при к-ром поле пространственного заряда головки лавины достигает внешнего. Это случается, когда в лавине нарождается $N \approx \exp[\alpha(E_0)d] \sim 10^8$ электронов или $\alpha(E_0)d \approx 18-20$ (условие Мика). Радиус стримерного канала $r \sim 10^{-2}-10^{-1}$ см; плотность зарядов в нём $n \sim 3N/4\pi r^3 \sim 10^{13}-10^{14}$ см⁻³; ток стримера (нагнетание положит. заряда в канал и вершину) $i_c \sim 10^{-3}-1$ А; скорость роста стримера $v_c \sim 10^8$ см/с. Новые порции газа ионизуются благодаря сильному собств. полю стримерной вершины, и в этом смысле процесс — самоподдерживающийся. Но внеш. поле (4,7 кВ/см в канале в атм. воздухе) всё равно необходимо, ибо энергию поставляет источник тока. В воздухе из-за прилипания стримерный канал теряет свою проводимость на расстоянии $v_c/v_a \sim 10$ см от вершины. Поэтому перекрытие стримером воздушного промежутка с $d \gtrsim 20$ см к пробою не приводит. В этих случаях действует лидерный механизм.

Лидер — плазменный канал, прорастающий со скоростью $v_c \sim 10^6$ см/с, но обладающий гораздо более высокой проводимостью благодаря повыш. темп-ре газа